

2SA1283

低周波電力増幅用
シリコンPNPエビタキシャル形

概要

2SA1283は、樹脂封止形シリコンPNPエビタキシャル形トランジスタです。耐圧が高い、コレクタ電流が大きい、さらにコレクタ損失が大きく、設計、製造されておりますので、リレードライブや電源等の汎用トランジスタとして、ご使用いただけます。

2SC3243とコンプリメンタリです。

特長

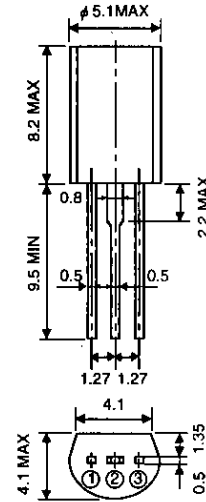
- 耐圧が高い $V_{CE0} = -60V$
- コレクタ電流が大きい $I_C = -1A$
- $V_{CE(sat)}$ が低い $V_{CE(sat)} = -0.11V$ 標準
($I_C = -500mA, I_B = -25mA$)
- コレクタ損失が大きい $P_C = 900mW$

用途

オーディオ機器、VTR、電装機器、その他電子機器のリレードライブ、電源

外形図

単位：mm



電極接続

- ①：エミッタ
- ②：コレクタ
- ③：ベース

EIAJ：—
JEDEC：—

最大定格 (Ta=25°C)

記号	項目	定格値	単位
V_{CB0}	コレクタ・ベース間電圧	-60	V
V_{EB0}	エミッタ・ベース間電圧	-6	V
V_{CE0}	コレクタ・エミッタ間電圧	-60	V
I_C	コレクタ電流	-1	A
I_{CM}	せん頭コレクタ電流	-2	A
P_C	コレクタ損失 (Ta=25°C)	900	mW
T_j	接合部温度	+150	°C
T_{stg}	保存温度	-55 ~ +150	°C

電気的特性 (Ta=25°C)

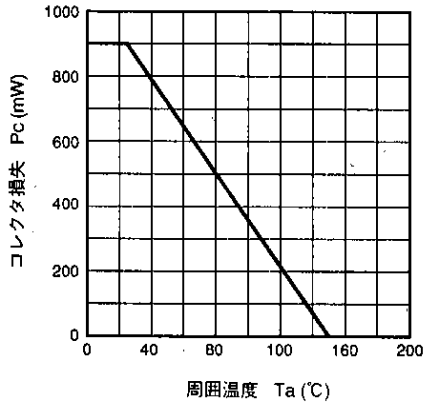
記号	項目	測定条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{(BR)CB0}$	コレクタ・ベース降伏電圧	$I_C = -10 \mu A, I_E = 0mA$	-60			V
$V_{(BR)EB0}$	エミッタ・ベース降伏電圧	$I_E = -10 \mu A, I_C = 0mA$	-6			V
$V_{(BR)CE0}$	コレクタ・エミッタ降伏電圧	$I_C = -2 mA, R_{BE} = \infty$	-60			V
I_{CB0}	コレクタしゃ断電流	$V_{CB} = -50 V, I_E = 0mA$			-0.2	μA
I_{EB0}	エミッタしゃ断電流	$V_{EB} = -4V, I_C = 0mA$			-0.2	μA
h_{FE}^*	直流電流増幅率	$V_{CE} = -4V, I_C = -0.1A$	55		300	—
$V_{CE(sat)}$	コレクタ・エミッタ飽和電圧	$I_C = -500mA, I_B = -25mA$		-0.11	-0.3	V
f_T	利得帯域幅積	$V_{CE} = -2V, I_E = 10mA$		85		MHz
C_{ob}	コレクタ出力容量	$V_{CB} = -10V, I_E = 0mA, f = 1MHz$		22		pF

*： h_{FE} の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

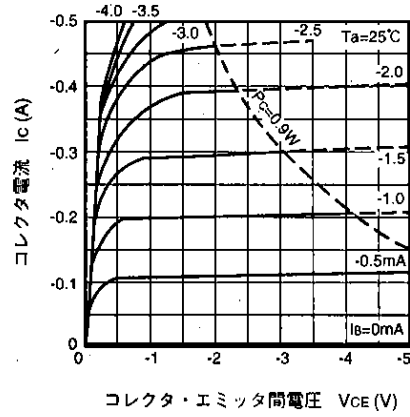
アイテム	C	D	E
h_{FE}	55 ~ 110	90 ~ 180	150 ~ 300

標準特性

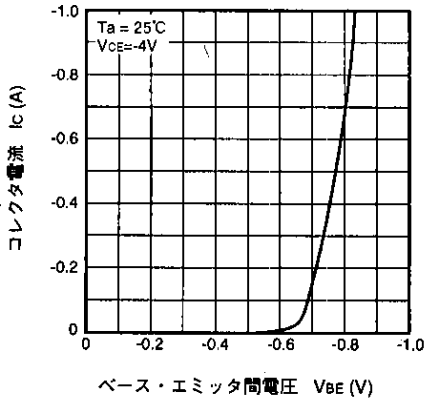
コレクタ損失—周囲温度特性



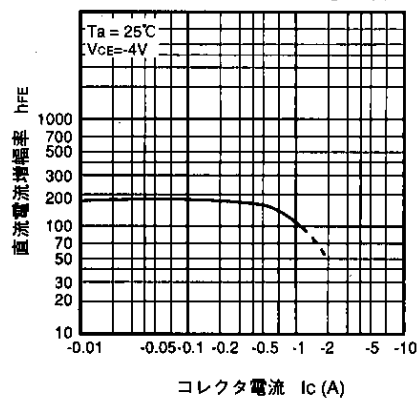
エミッタ接地出力特性



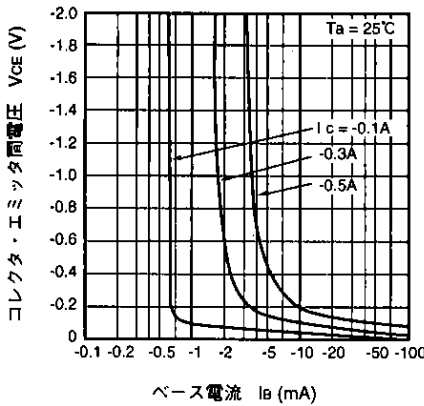
エミッタ接地伝達特性



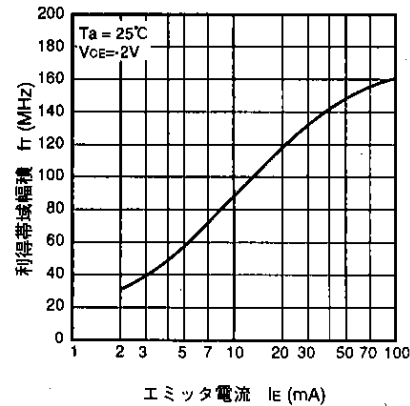
直流電流増幅率—コレクタ電流特性



コレクタ・エミッタ飽和電圧—ベース電流特性



利得帯域増幅積—エミッタ電流特性



2SA1283

低周波電力増幅用
シリコンPNPエヒタキシャル形

